⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 昭63-228101

Mint Cl.	1	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和63年(198	38) 9月22日
G 02 B B 32 B	1/10 7/02	1 0 3 1 0 4	A-8106-2H 6804-4F 6804-4F				
G 02 B	17/06 · 5/28	101	6122-4F 7348-2H	審査請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)

図発明の名称 防汚性を有する帯電防止無反射板

②特 願 昭62-61808

②出 願 昭62(1987)3月17日

⑦発 明 者 符 井 正 博 大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 日本板硝子株式会 社内 ⑦発 明 者 花 田 良 幸 大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 日本板硝子株式会

⑦発 明 者 前 田 真 寿 大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 日本板硝子株式会 社内

⑫発 明 者 円 城 寺 勝 久 大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 日本板硝子株式会 社内

①出 願 人 日本板硝子株式会社 大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地

砂代 理 人 弁理士 大野 精市

明 細 書

/ 発明の名称

防汚性を有する帯電防止無反射板

ュ 特許請求の範囲

- (1) 透明な高屈折率膜と低屈折率膜とを交互に重ね合せ、最表面層が低屈折率膜となる反射防止膜であって、設高屈折率膜の少なくとも!つの原を透明端電膜を用いた反射防止膜を透明基板におした帯電防止無反射板において、最表面層となるか、低屈折率膜上に含っっ素高分子膜に置換したことを特徴とする防汚性を有する帯電防止無反射板。
- (2) 前記透明導電膜が錫をドーブした酸化インジウム、酸化第二錫、及び酸化亜鉛の少なくともいずれか/確を主成分とする膜である特許請求の範囲 第/項に記載の妨汚性を有する帯電防止無反射板。
- (3) 前記含ファ菜高分子膜ががりピニリデンフロライド、ポリトリフルオロエチレン、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーへキャンコート

サフルオロプロピレン共重合体、ヘキサフルオロプロピレン、エチレンーテトラフルオロエチレン 共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、ファ素系シリコーン樹脂、含ファ素アルキルシラン、及び含ファ素アルキルアセチレンのいずれか!種の膜である特許請求の範囲新!項又は第2項に記載の防汚性を有する帯電防止無反射板。

3. 発明の評細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は表面が防汚性をもつ帯電防止無反射板に関する。

(従来の技術)

従来、常電防止無反射板としては、ガラス板等の透明基板表面に、透明な高風折率無機膜と低原 折率無機膜とを交互に付着させ、高屈折率無機膜 のノつに透明導電膜を用いた常電防止無反射板が 特開昭 6 / - / 68899 により知られている。

また、無反射板の表面の汚れを防止したものと して、透明基板と同程度以上の屈折率を有するシ ラン化合物強膜等を該透明基板に付着し、該強膜 上にポリァルオロ化基含有化合物からなる薄膜を 形成した防汚 性無反射板が特開型 59-1/5840 号により知られている。

(発明が解決 しようとする問題点)

しかしながら、無機透明膜を用いた帯電防止無 反射板は油性の汚れに対しては防汚効果がなく、 有機透明膜を用いた防汚性無反射板はほこりに対 して防汚効果が少ない。そして、シラン化合物強 膜とポリッルオロ化基含有化合物薄膜を形成した 無反射板は表面がマッ素系合分子や有の表面エキ ルギーが低いことから、水、油等の付着をさまた げる効果はあるが、シラン化合物強膜等の樹脂膜 に高い屈折率を有するものが得られないため、無 反射の特性が劣るという欠点があった。

本発明は前記した従来の無反射板の有する欠点 を一挙に解決するためになされたものである。

〔問題を解決するための手段〕

すなわち、本発明は透明な高屈折事膜と低屈折 事膜とを交互に重ね合せ、最衰面層が低屈折事膜 となる反射防止膜であって、該高屈折事膜の少な

れかの膜が用いられる。

(作用)

本発明は、反射防止膜の高屈折率膜の少なくとも!つに帯電防止のための透明導電膜を用い、且つ最表面閣となる膜上に低屈折率で、且つ表面エキルギーの低い含マッ素高分子膜を形成したものであるから、無反射板の表面に帯電による集庫や水、油の吸着が生じにくくなる。

(実施例/)

以下、本発明を図面に示した実施例について説明する。

屈折率 1.81 であるガラス板(1)の表面に、屈折率が 1.83 で、且つ光学厚みが 0.09 5・ λ_0 (λ_0) は可視光中心波長)の ITO 腰 かな る電導性高屈折率 版(2) 蒸着法により形成し、この高屈折率 膜(2)上に屈折率が 1.38 で、且つ光学厚みが 0.063- λ_0 の 免化マグネンウムの低屈折率 膜(3)を蒸着法により形成し、この低屈折率 段(3)上に屈折率が 2.10で、且つ光学厚みが 0.300・ λ_0 の酸化チタンと酸化プラセオンムの混合物からなる高屈折率 膜(4)

本発明において、透明導電膜としては鍋をドープした酸化インジウム(ITO)、酸化第二鍋(SnO₂)、及び酸化亜鉛(ZnO)の少なくともいずれか/種を主成分とする膜を用いることができる。

また、本発明において、含ファ素高分子膜としてポリビニリデンフロライド (PVDF)、 ポリトリフルオロエチレン (PTFE)、ポリテトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン共富合体 (FEP)、ヘキサフルオロプロピレン (HFP)、エチレンーテトラフルオロブロピレン 共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン (PCTFE)、ファ素系シリコーン樹脂、含ファ素アルキルシラン ((CF5)2CFO(CH2)3

を蒸着法により形成し、更にその上に光学厚みが の./95・ λ_0 の非化マグキシウムの低屈折率膜(5)を 蒸着し、その上に屈折率が / .35 で、且つ光学厚 みが 0.490・ λ_0 の PTFE 層(6)を形成して防汚性を 有する帯電防止無反射板を得た。

第/表にその膜構成を示した。

PTPR 暦(6)は、エレクトロンビーム蒸着法のほかRFスパック法又はプラズマ重合等の方法で形成できる。また、 PTPR 暦(6)に代え溶媒に浴ける含ァッ素高分子を用いる場合にはディッピング法又はスピンコート法も用いることができる。そして、得られた防汚性を有する帯電防止無反射板はPTPR 暦(6)が低屈折率膜(5)と共に無反射性能に寄与し、第2図に示す如き反針率特性を示した。

- 1	物 質	屈折率	光学膜厚
新工用	PTFE	1.35	0.490.20
第4册	MgF ₂	1.38	0.195-20
练3周	$T10_2 + Pr_60_{11}$	2./0	0.500· 20
第2層	MgF2	1.38	0.063.20
第/唐	ITO	1.83	0.095.20
美板	ガラス板	1.51	

(実施例2)

. ¥

実施例/と阿様にして第2妻に示す如き、反射防止談を屈折率 / . s / であるガラス板の表面に付着した。

	箅	2	
4 1.5	物質	屈折零	光学膜摩
第5階	含ファ紫アルキル シラン	1.50	-
第4階	S102	1.46	0.2883 - 20
第3階	TiO2	2.40	0.0985-20
第2胎	SiO ₂	1.46	0.0080.10
第7階	ITO	1.85	0.3463-20
基板	ガラス板	1.51	_

第 / 層から第3 層までは突施例 / と同様の方法により、第4 層のポリトリフルオロエチレン
(PTTFE)はジメチルアセトアミド (DMA)により溶液としてスピンナーを使用して第4 妻に示した反射防止膜を、屈折率 / よ/ のガ ラス板の表面に付着した。

第 4 费

	物質	慰折率	光学族厚
第4層	PTFFE	1.36	0.3240-20
第3階	TiO2 + Pr6011	2.10	0.//48.20
第2胎	MgF2	1.38	0.1048-20
第/階	ITO	1.85	0.1495-20
差板	ガラス板	1.51	-

得られた防汚性を有する帯電防止無反射板の反射率特性を第3図に示した。

(発明の効果)

以上のように、本発明は、反射防止膜の高風折 事膜の少なくとも!つに帯電防止のための透明導 健膜を用い、且つ機表面耐となる低屈折率膜上に 低屈折率で、且つ表面エネルギーの低い含ファ素 第 / 層及び第 4 層は蒸着法により形成し、第 3 層は気相重合法により単分子製を形成した。 られた防汚性を有する帯電防止無反射板は第 3 図の 反射率 性を示した。

(英施例3)

第 4 層の S102 K代え MgF2 とし、第 5 層の形成 Kスピンコートを用いた他は実施例 4 と同様の方法で第 3 表 K示した反射防止膜を屈折率 /.s/のガラス板の表面に付着した。

第 3 表

	物 質	胆折率	光学談摩
第5層	含ファ東アルキル シラン	. 1.50	_
第4船	S10 ₂	1.46	0.2830 - 10
第3階	TiO2	2.40	0.1008-10
第2層	MgF 2	/.38	0.0078 - 20
第/服	170	1.85	0.3400.10
基板	ガラス板	1.51	_

得られた防汚性を有する帯電防止無反射板の反射 事特性を第4図に示した。

(实施例4)

高分子膜を形成したものであるから、無反射板の 表面に帯電による集唐や水、油の吸着が生じにく くなるため、無反射性能を維持したまま、表面の 汚れるのを防止することができる。

4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の突筋例を示すものであって、第 / 図は常電防止無反射板の縦断面図、第 2 図乃至 第 3 図は夫々実施例 / 乃至実施例 4 で得られた常電防止無反射板の反射率等性を示すグラフである。

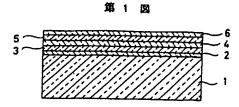
(1): ガラス板、(2): 電導性高屈折率膜、

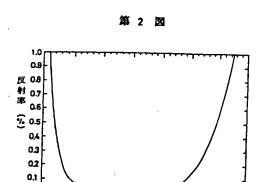
(3),(5):低瓜折率膜、(4):高屈折率膜、

(6): PTFE 磨

特許出顧人 日本板硝子株式会社 代理人 弁理士 大 野 帶 市







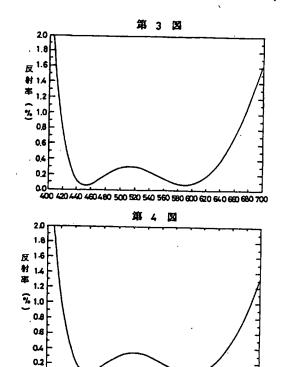
500 550 600 波長 (nm)

650

700

م.ولب 400

450



0.0 420 440 460 480 500 520 540 580 580 600 620 640 560 680 700 88 98 (nm)



